

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук
объявляет конкурс на замещение вакантной должности
заведующего лабораторией
в лаборатории неравновесных процессов в полупроводниках
Вакансия VAC 128918

Тематика исследований

Исследования и разработки в области электронных, оптических и спиновых явлений в полупроводниковых, полимерных, перовскитных и композитных материалах и структурах для гибкой органической электроники.

Трудовая деятельность

- постановка цели и задач научно-исследовательских работ в рамках тематики Государственного задания и научных проектов лаборатории, организация рабочего взаимодействия членов коллектива, контроль за материальным и техническим обеспечением научного коллектива, необходимым для успешной реализации проводимых в лаборатории исследований;
- осуществление мониторинга за выполняемой членами научного коллектива работой, её соответствием целям и задачам лаборатории, а также плану работ и срокам их реализации;
- анализ и обсуждение результатов, полученных членами научного коллектива, ориентация результатов на публикацию в рецензируемых научных изданиях и представление в форме докладов на конференциях и семинарах;
- руководство в подготовке публикаций в рамках отчетности лаборатории по выполнению Государственного задания в форме статей, заявок на изобретения, докладов на конференциях, а также взаимодействие с внешними научными коллективами;
- обобщение полученных результатов и их представление в отчетных документах и выступлениях; подготовка основных выводов и отчетных материалов по работе; взаимодействие с административными сотрудниками и службами Института;
- корректировка плана исследований по научно-исследовательским проектам лаборатории, а также состава научного коллектива и распределения работ в процессе достижения поставленных целей и задач.

Требования к претенденту

- ученая степень доктора физико-математических наук по специальности физика полупроводников (01.04.10);
- наличие опыта руководства научными подразделениями не менее 6 лет;
- наличие не менее 55 публикаций в рецензируемых научных изданиях, из них не менее 40 в изданиях, индексируемых в WoS/Scopus (в т.ч. не менее 12 из них – в изданиях Q1 и Q2) за последние 5 лет;
- наукометрические показатели: индекс Хирша (WoS) – не ниже 25, индекс цитирования (WoS) – не ниже 2300;
- наличие достижений, подтверждающих выдающиеся научные результаты в указанной области исследований, награждение медалью «За вклад в реализацию государственной политики в области научно-технологического развития» Министерства науки и высшего образования РФ, победы в конкурсах лучших работ отделения ФТИ;
- наличие опыта успешного участия в научных проектах Российского научного фонда (РНФ);
- наличие опыта педагогической деятельности в качестве профессора кафедры Микронанoeлектроники СПбГЭТУ "ЛЭТИ" в том числе чтение курса лекций для магистрантов 2-го года: «Органическая электроника», наличие опыта руководства

диссертационными работами: не менее 2-х магистрантов СПбГЭТУ "ЛЭТИ" и 2-х аспирантов ФТИ им. А.Ф. Иоффе;

- членство в ученых советах ФТИ им. А.Ф. Иоффе и Отделения твердотельной электроники ФТИ им. А.Ф. Иоффе, членство в диссертационном совете СПбГЭТУ "ЛЭТИ", членство в редколлегии Журнала технической физики;

- наличие опыта участия в экспертно-аналитической и общественно-организационной деятельности, участие в работе в качестве эксперта в Федеральном реестре экспертов научно-технической сферы ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ Минобрнауки РФ.

Конкретные обязанности будут определяться исходя из квалификации соискателя.

- ДОЛЖНОСТНОЙ ОКЛАД: 37 634 руб.
- СТАВКА: 0,5
- Срок трудового договора – 5 лет

К заявлению об участии в конкурсе должны прилагаться следующие документы

- копии документов о высшем профессиональном образовании;
- копии документов о присуждении ученой степени, присвоении ученого звания;
- сведения о научной (научно-организационной) работе за пять лет, предшествовавших дате объявления конкурса, список публикаций;

Документы следует направлять по адресу: 194021, г. Санкт-Петербург, Политехническая ул., д. 26, ученому секретарю ФТИ им. А.Ф. Иоффе М.И. Патрову, телефон для справок: (812) 297 22 45.